

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Глава первая ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ . . . . .	6
1. 1. Некоторые сведения о строении атома . . . . .	6
1. 2. Энергия и движение электрона в твердом теле . .	10
1. 3. Электропроводность полупроводников . . . . .	36
1. 4. Теплопроводность полупроводников . . . . .	43
1. 5. Контактные явления . . . . .	55
1. 6. Термоэлектрические явления . . . . .	75
1. 7. Гальваномагнитные и термомагнитные явления	83
1. 8. Фотопроводимость . . . . .	100
Глава вторая СТРОЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ . . . . .	113
2. 1. Некоторые вопросы квантовой теории . . . . .	113
2. 2. Геометрия кристаллической решетки . . . . .	147
2. 3. Дефекты в кристаллах . . . . .	163
2. 4. Тепловые колебания кристаллов . . . . .	174
2. 5. Теплоемкость . . . . .	184
Глава третья ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ КРИСТАЛЛОВ . . . . .	190
3. 1. Адиабатическое приближение . . . . .	190
3. 2. Одноэлектронное приближение . . . . .	194
3. 3. Приближение почти свободных электронов .	198
3. 4. Приближение сильно связанных электронов .	207
3. 5. Основные особенности структуры энергетических зон полупроводников . . . . .	209
Глава четвертая СТАТИСТИКА ЭЛЕКТРОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ . . . . .	217
4. 1. Некоторые понятия статистики и термодинамики	217
4. 2. Распределение Ферми . . . . .	224
4. 3. Статистика невырожденного электронного газа в полупроводниках . . . . .	226
4. 4. Энергия электронов в зоне проводимости, вырождение . . . . .	235
Глава пятая НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯВЛЕНИЙ ПЕРЕНОСА . . . . .	244
5. 1. Элементарный расчет электропроводности и подвижности . . . . .	245
5. 2. Кинетическое уравнение (учет энергетической зависимости времени релаксации) . . . . .	260

5. 3. Феноменологический анализ явлений переноса . . . . .	270
5. 4. Вычисление времени релаксации . . . . .	271
5. 5. Явления в сильных электрических полях . . . . .	278
<b>Глава шестая</b>	
<b>ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ . . . . .</b>	<b>292</b>
6. 1. Термоэлектродвижущая сила . . . . .	294
6. 2. Вывод коэффициента термо- э.д.с. из кинетического уравнения . . . . .	296
6. 3. Увлечение электронов фононами . . . . .	299
6. 4. Зависимость термо- э.д.с. от температуры и концентрации носителей . . . . .	304
6. 5. Электронная теплопроводность . . . . .	311
6. 6. Теплопроводность кристаллической решетки . . . . .	317
6. 7. Фотонная теплопроводность . . . . .	329
<b>Глава седьмая</b>	
<b>ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ И ТЕРМОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ . . . . .</b>	<b>331</b>
7. 1. Общие сведения . . . . .	331
7. 2. Эффект Холла и изменение сопротивления в магнитном поле . . . . .	341
7. 3. Эффект Эттингсгаузена . . . . .	350
7. 4. Гальваномагнитные явления в сильных магнитных полях . . . . .	351
7. 5. Термомагнитные явления . . . . .	355
<b>Глава восьмая</b>	
<b>КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ . . . . .</b>	<b>362</b>
8. 1. Особенности контактных явлений . . . . .	362
8. 2. Контакт полупроводника и металла . . . . .	366
8. 3. Диффузионная теория выпрямления Мотта (химический барьерный слой на границе металла с полупроводником) . . . . .	368
8. 4. Диодная теория Бете . . . . .	373
8. 5. Теория физического запорного слоя (теория истощения Шоттки) . . . . .	375
8. 6. Теория <i>p-n</i> перехода . . . . .	378
<b>Глава девятая</b>	
<b>ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ . . . . .</b>	<b>400</b>
9. 1. Поглощение света . . . . .	400
9. 2. Фотопроводимость . . . . .	409
9. 3. Фотовольтаические эффекты . . . . .	421
9. 4. Циклотроинный резонанс . . . . .	426
9. 5. Стимулированное излучение . . . . .	430
<b>Литература . . . . .</b>	<b>441</b>
<b>Предметный указатель . . . . .</b>	<b>443</b>